

エキシトントランジスタ実現に向けたZnIn₀Nの創製

松島, 宏一

<https://doi.org/10.15017/1807054>

出版情報：九州大学, 2016, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済

氏 名	松島宏一			
論 文 名	エキシトントランジスタ実現に向けた ZnInON の創製			
論文調査委員	主 査	九州大学	教授	白谷正治
	副 査	九州大学	准教授	中村大輔
	副 査	九州大学	准教授	板垣奈穂
	副 査	九州大学	准教授	古閑一憲

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本研究は、不純物添加結晶化法という新規プロセスにより **ZnInON** という新材料の単結晶薄膜形成を実現し、これを用いた新構造の歪量子井戸型エキシトンデバイスでエキシトン流の変調に室温で成功したもので、電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文は博士（工学）の学位に値するものと認める。